

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ (PCT方式)  
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

2SA561

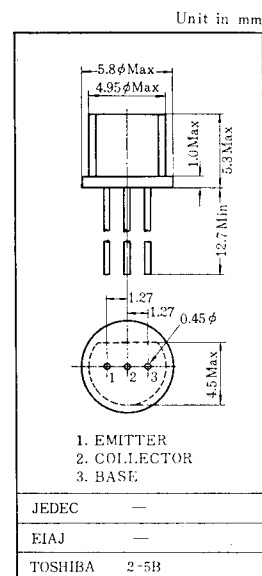
○励振段増幅用

○ Driver Stage Amplifier Applications

- 高耐圧です； $V_{CE0} = -50V$ (Min.)
- 飽和電圧が低い； $V_{CE(sat)} = -0.3V$ (Max.)
- 2SC734とコンプリメンタリになります。
- Complementary to 2SC734

最大定格 MAXIMUM RATINGS ( $T_a = 25^\circ C$ )

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	-50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-50	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-5	V
コレクタ電流	$I_C$	-150	mA
エミッタ電流	$I_E$	150	mA
コレクタ損失	$P_C$	300	mW
接合温度	$T_j$	125	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-55~125	$^\circ C$



電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a = 25^\circ C$ )

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -18V, I_E = 0$	—	—	-0.1	$\mu A$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	—	—	-0.1	$\mu A$
直流電流増幅率 (Note)	$h_{FE(1)}$	$V_{CE} = -1V, I_C = -20mA$	70	—	400	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -5V, I_C = -150mA$	23	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -100mA, I_B = -10mA$	—	—	-0.3	V
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$I_C = -100mA, V_{CE} = -1V$	—	-0.7	—	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = -6V, I_E = 1mA$	—	70	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -6V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	13	—	pF

Note ;  $h_{FE(1)}$ および $h_{FE(2)}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of  $h_{FE(1)}$  and  $h_{FE(2)}$ , the 2SA561 is classified as follows.

Classification	$h_{FE(1)}$		$h_{FE(2)}$
	Min.	Max.	Min.
2SA561—O	70	140	23
2SA561—Y	120	240	40
2SA561—GR	200	400	67